

● 最大额定值

参数	符号	额定值	单位
集电极-发射极电压 ($I_B=0$)	V_{CE0}	32	V
集电极-基极电压 ($I_E=0$)	V_{CB0}	40	V
发射极-基极电压 ($I_C=0$)	V_{EB0}	6	V
集电极电流	I_C	1.5	A
总耗散功率 ($T_A=25^\circ\text{C}$)*	P_{tot}	500	W
最高结温	T_{jm}	150	$^\circ\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

* 器件安装在陶瓷基板上

NPN-硅通用晶体管

500mW、1.5A、32V



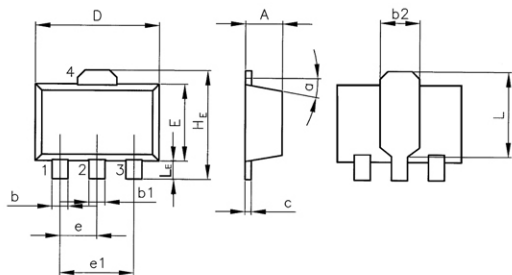
SOT-89

● 电特性 (除非另有规定, $T_A=25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
击穿电压	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=1\text{mA}$, $I_B=0$	32	—	—	V
	$V_{(BR)CB0}$	$I_C=50\ \mu\text{A}$, $I_E=0$	40	—	—	V
	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=50\ \mu\text{A}$, $I_C=0$	6	—	—	V
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}$, $I_E=0$	—	—	500	nA
直流放大系数	h_{FE}	$I_C=100\text{mA}$, $V_{CE}=3.0\text{V}$	120	—	240	—
集电极-发射极饱和电压 ¹⁾	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$	—	—	0.50	V
特征频率	f_T	$I_C=50\text{mA}$, $V_{CE}=5\text{V}$	150	—	—	MHz

1) 脉冲法: 脉宽 300 μs , 占空比 $\leq 2\%$

SOT-89 外形尺寸



1 基极 2 集电极 3 发射极 4 集电极

单位: mm

尺寸 符号	SOT-89			尺寸 符号	SOT-89		
	min	typ	max		min	typ	max
A		1.5		e		1.5	
b			0.65	e1		3	
b1			0.65	H_{FE}			4.25
b2		1.6		L	2.6		2.95
c	0.25			L_{FE}	0.8		1.2
D		4.5		α			10 $^\circ$
E			2.6				

